



**Eur päisches
Patentamt**

**Eur pean
Patent Office**

**Office eur péen
des brevets**

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

01116916.6

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

I.L.C. HATTEN-HECKMAN

DEN HAAG, DEN
THE HAGUE, 13/08/01
LA HAYE, LE

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Blatt 2 der Bescheinigung
Sheet 2 of the certificate
Page 2 de l'attestation

Anmeldung Nr.:
Application no.: 01116916.6
Demande n°:

Anmeldetag:
Date of filing: 11/07/01
Date de dépôt:

Anmelder:
Applicant(s):
Demandeur(s):
Carl Zeiss
89518 Heidenheim (Brenz)
GERMANY

Carl-Zeiss-Stiftung, trading as Carl Zeiss
89518 Heidenheim (Brenz)

GERMANY
Bezeichnung der Erfindung:
Title of the invention:
Titre de l'invention:

6-Spiegel-Mikrolithographie-Projektionsobjektiv

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat: DE
State:
Pays:

Tag: 01/08/00
Date:
Date:

Aktenzeichen:
File no.
Numéro de dépôt:

DEA 10037870

Internationale Patentklassifikation:
International Patent classification:
Classification internationale des brevets:

/

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten:
Contracting states designated at date of filing: AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE/TR
Etats contractants désignés lors du dépôt:

Bemerkungen:
Remarks:
Remarques:

PAGE BLANK (USPTO)

6-Spiegel-Mikrolithographie-Projektionsobjektiv

Die Erfindung betrifft ein Mikrolithographieobjektiv gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1, eine Projektionsbelichtungsanlage gemäß Anspruch 21 sowie ein Chipherstellungsverfahren gemäß Anspruch 22.

Die Lithographie mit Wellenlängen < 193 nm, insbesondere die EUV-Lithographie mit $\lambda = 11$ nm bzw. $\lambda = 13$ nm werden als mögliche Techniken zur Abbildungen von Strukturen < 130 nm, besonders bevorzugt < 100 nm diskutiert. Die Auflösung eines lithographischen Systems wird durch nachfolgende Gleichung beschrieben:

$$RES = k_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$$

wobei k_1 ein spezifischer Parameter des Lithographieprozesses, λ die Wellenlänge des einfallenden Lichtes und NA die bildseitige, numerische Apertur des Systems bezeichnet.

Für abbildende Systeme im EUV-Bereich stehen als optische Komponenten im wesentlichen reflektive Systeme mit Multilayer-Schichten zur Verfügung. Als Multilayer-Schichtsysteme finden bei $\lambda = 11$ nm bevorzugt Mo/Be-Systeme und bei $\lambda = 13$ nm Mo/Si-Systeme Verwendung.

Legt man eine numerische Apertur von 0,2 zugrunde, so erfordert die Abbildung von 50 nm-Strukturen mit 13 nm-Strahlung einen vergleichsweise einfachen Prozeß mit $k_1 = 0,77$. Mit $k_1 = 0,64$ wird bei 11 nm-Strahlung die Abbildung von 35 nm-Strukturen möglich.

Da die Reflektivität der eingesetzten Multilayer-Schichten nur im Bereich von ungefähr 70 % liegt, ist es bei den Projektionsobjektiven für die EUV-Mikrolithographie von ganz entscheidender Bedeutung, zum Erreichen

einer ausreichenden Lichtstärke mit möglichst wenig optischen Komponenten im EUV-Projektionsobjektiv auszukommen.

5 Als besonders bevorzugt haben sich mit Blick auf eine hohe Lichtintensität und ausreichende Möglichkeiten zur Korrektur von Abbildungsfehlern bei $NA = 0,20$ Systeme mit sechs Spiegeln herausgestellt.

10 6-Spiegel-Systeme für die Mikrolithographie sind aus den Druckschriften US-A-5 153 898, EP-A-0 252 734, EP-A-0 947 882, US-A-5686728, EP 0 779 528, US 5 815 310, WO 99/57606 und US 6 033 079 bekannt geworden.

15 Das Projektions-Lithographiesystem gemäß der US-A-5 686 728 zeigt ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln, wobei jede der reflektiven Spiegelflächen asphärisch ausgebildet ist. Die Spiegel sind entlang einer gemeinsamen optischen Achse so angeordnet, daß ein obskurationfreier Lichtweg erreicht wird.

20 Da das aus der US-A-5 686 728 bekannte Projektionsobjektiv nur für UV-Licht mit einer Wellenlänge von 100 - 300 nm eingesetzt wird, weisen die Spiegel dieses Projektionsobjektives eine sehr hohe Asphärizität von ungefähr $\pm 50 \mu m$ sowie sehr große Einfallswinkel von ca. 38° auf. Auch nach Abblenden auf $NA = 0,2$ verbleibt hier eine Asphärizität von $25 \mu m$ von Spitze zu Spitze bei kaum vermindertem Einfallswinkel. Derartige
25 Asphärizitäten und Einfallswinkel sind im EUV-Bereich wegen der hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität, Reflektivität der Spiegel nicht praktikabel.

30 Ein weiterer Nachteil des aus der US-A-5 686 728 bekannt gewordenen Objektives, der einen Einsatz im Bereich von $\lambda < 100 \text{ nm}$, insbesondere bei den Wellenlängen von 11 und 13 nm nicht mehr erlaubt, ist der sehr

geringe Abstand zwischen dem Wafer und dem dem Wafer am nächsten
liegenden Spiegel. Bei den aus der US-A-5 686 728 bekanntgewordenen
Abständen von Wafer und wäfernächstem Spiegel können die Spiegel nur
sehr dünn ausgebildet werden. Wegen der extremen Schicht-Spannungen
in den Multilayer-Systemen für die angesprochenen Wellenlängen von 11
und 13 nm sind derartige Spiegel sehr instabil.

Aus der EP-A-0 779 528 ist ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln zum
Einsatz in der EUV-Lithographie, insbesondere auch bei Wellenlängen von
13 nm und 11 nm, bekanntgeworden.

Auch dieses Projektionsobjektiv hat den Nachteil, daß mindestens zwei der
insgesamt sechs Spiegel sehr hohe Asphäritäten von 26 bzw. 18,5 μm
aufweisen. Insbesondere ist aber auch bei der aus der EP-A-0779528
bekannten Anordnung der optische freie Arbeitsabstand zwischen
wäfernächstem Spiegel und Wafer derart gering, daß es entweder zu
Instabilitäten oder aber einem mechanisch freien Arbeitsabstand, der
negativ ist, kommt.

Aus der WO 99/57606 ist ein 6-Spiegel-Projektionsobjektiv für die EUV-
Lithographie mit einer Spiegelabfolge konkav - konkav - konvex - konkav -
konvex - konkav gezeigt, das eine numerische Apertur am Objekt $NA_{\text{Objekt}} =$
0,2 aufweist. Alle Spiegel des aus der WO 99/57606 bekannten Systems
sind asphärisch ausgebildet.

Nachteilig an dem aus der WO 99/57606 bekannten 6-Spiegel-Objektiv ist,
daß eine leichte Zugänglichkeit der Nutzbereiche beispielsweise für eine
Einfassung insbesondere am zweiten und dritten Spiegel nicht gegeben ist.
Desweiteren ist der Nutzbereich des vierten Spiegels bei dem aus der WO
99/57606 bekannten System weit außerhalb der optischen Achse
angeordnet. Dies führt zu Problemen in bezug auf die Stabilität des

Spiegelsystems und bei der Herstellung dieses Spiegelsegmentes. Auch wird ein großer umbauter Raum benötigt, um das System zu kapseln. Da das System im Vakuum eingesetzt wird, ist ein relativ großer Raum zu evakuieren.. Die gemäß der WO99/57606 zwischen dem zweiten und dem dritten Spiegel angeordnete Blende hat große Inzidenzwinkel auf dem

5 dritten Spiegel zur Folge, die insbesondere größer als 18° sind.

Aus der US 6033079 ist ein 6-Spiegel-System bekannt, bei dem die Inzidenzwinkel auf allen Spiegeln kleiner als 18° sind. Allerdings hat auch dieses System den Nachteil, daß der Nutzbereich des dritten Spiegels nicht zugänglich ist und die Nutzbereiche einzelner Spiegel, beispielsweise des vierten Spiegels (M4) so groß sind, daß wie bei dem aus der WO 99/57606 bekannten System ein großer umbauter Raum benötigt wird, was wiederum einen relativ großen zu evakuierenden Raum zur Folge hat. Ein weiterer

10

15

Nachteil von relativ großen Spiegeln ist deren mangelnde Stabilität und die Tatsache, daß entsprechend große Beschichtungskammern und Fertigungsmaschinen für deren Herstellung benötigt werden.

Aufgabe der Erfindung ist es somit, eine für die Lithographie mit kurzen Wellenlängen, vorzugsweise kleiner 100 nm, geeignetes Projektionsobjektiv anzugeben, das die zuvor erwähnten Nachteile des Standes der Technik nicht aufweist, insbesondere soll ein Projektionsobjektiv angegeben werden, das sich durch möglichst geringe Abmessungen, eine gute

20

25

Zugänglichkeit des Nutzbereiches eines jeden Spiegels auszeichnet sowie eine möglichst große Apertur und möglichst große Korrektionsmöglichkeiten betreffend Abbildungsfehler aufweist.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen, vorzugsweise ≤ 193 nm gelöst, das eine Eintrittspupille und eine Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt,

30

umfasst, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse aufweist und die Ausdehnung mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist sowie einen ersten, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften und einen sechsten Spiegel in zentrierter

5 Anordnung zu einer optischen Achse umfasst, wobei jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, auftreten und der Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels in Abhängigkeit von der numerischen Apertur NA an der

10 Austrittspupille $\leq 1200\text{mm} \cdot \text{NA}$ ist, bevorzugt $\leq 300\text{ mm}$, wobei die numerische Apertur NA an der Austrittspupille des erfindungsgemäßen Objektivs ist größer als 0,1, bevorzugt größer als 0,2, besonders bevorzugt größer als 0,23. Unter numerischer Apertur an der Austrittspupille wird in vorliegender Anmeldung die numerische Apertur des auf die Bildebene

15 auftreffenden Strahlbüschels verstanden, die sogenannte bildseitige numerische Apertur.

Im Bereich der Mikrolithographie ist es vorteilhaft, wenn das abbildende Strahlbündel telezentrisch auf die Bildebene trifft. Vorteilhafterweise ist dann

20 der sechste Spiegel des Projektionsobjektives S6 konkav geformt. Der fünfte Spiegel S5 liegt zwischen dem sechsten Spiegel S6 und der Bildebene.

Will man bei einem derartigen Objektiv einen abschattungsfreien Strahlengang realisieren, so wirkt sich dies auf die numerische Apertur NA

25 an der Austrittspupille aus.

In einer vorteilhaften Ausführungsform wird ein abschattungsfreier Strahlengang im Objektiv dadurch realisiert, daß mit steigender

30 numerischer Apertur an der Austrittspupille auch der mittlere Radius des abzubildenden Ringfeldes wächst.

Die Zugänglichkeit der einzelnen Spiegel des Objektivs, insbesondere zum Zwecke der Einfassung der Spiegel wird in einer fortgebildeten Ausführungsform gewährleistet, wenn der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel jeweils einen rückwärtigen Bauraum aufweist, der entlang der optischen Achse gemessen von der Spiegelvorderseite im Nutzbereich eine Tiefe aufweist, wobei die Tiefe jeweils des ersten, zweiten, dritten, vierten und sechsten Bauraumes mindestens 50 mm und die Tiefe des Bauraumes des fünften Spiegels größer als $1/3$ des Wertes des Durchmessers des fünften Spiegels ist und sich die jeweiligen Bauräume nicht durchdringen.

Besonders vorteilhaft mit Blick auf die Zugänglichkeit ist es, wenn alle Bauräume in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird.

Ein besonders stabiles System im Hinblick auf die schichtspannungs-induzierten Randdeformationen erhält man, wenn der Randbereich umlaufend um den Nutzbereich aller Spiegel mehr als 4 mm beträgt, wobei die Lichtführung im Objektiv obskurationsfrei erfolgt.

Die Beschichtung der Spiegelsubstrate mit den zuvor erwähnten Mo/Be oder Mo/Si-Vielfachschichtsystemen haben oftmals Spannungen zur Folge, die besonders am Rand des Substrates zu Deformationen führen können. Ein ausreichend großer Randbereich verhindert, daß diese sich in den Nutzbereich des Spiegels fortsetzen.

In einer bevorzugten Ausführungsform liegt der Nutzbereich des vierten Spiegels geometrisch zwischen zweitem Spiegel und der Bildebene.

Besonders bevorzugt ist es, wenn der vierte Spiegel geometrisch zwischen
drittem und zweitem Spiegel, insbesondere zwischen erstem und zweitem
Spiegel angeordnet ist. Eine derartige Anordnung hat besonders geringe
Abmessungen der Nutzbereiche des ersten, zweiten, dritten und vierten
Spiegels zur Folge.

Der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von viertem
und erstem Spiegel ($S_4 S_1$) zum Abstand von zweitem und erstem Spiegel
($S_2 S_1$) liegt vorteilhafterweise im Bereich

$$0,1 < \frac{(S_4 S_1)}{(S_2 S_1)} < 0,9$$

und der Abstand von drittem und zweitem Spiegel ($S_2 S_3$) zum Abstand
von viertem zu drittem Spiegel ($S_4 S_3$) im Bereich

$$0,3 < \frac{(S_3 S_4)}{(S_2 S_3)} < 0,9$$

Um einen abschattungsfreien Strahlengang zu erreichen, gibt es
insbesondere im Objektivteil umfassend den fünften und den sechsten
Spiegel zwei kritische Bereiche.

Der eine Bereich liegt am oberen Rand des fünften Spiegels. Die
Strahlführung muß dort so erfolgen, daß die unteren Randstrahlen oberhalb
des Nutzbereiches dieses Spiegels verlaufen und auf die Bildebene
auftreffen. Der andere Bereich liegt am unteren Rand des sechsten
Spiegels.

Ein abschattungsfreier Strahlverlauf wird in den oben genannten Bereichen
am fünften und sechsten Spiegel in paraxialer Näherung erreicht, wenn der

mittlere Ringfeldradius in Abhängigkeit von der numerischen Apertur NA an der Austrittspupille, den Abständen der Spiegelscheitel von fünftem und sechsten Spiegel (S5 S6), den Abstand von fünftem Spiegel und Bildebene (S5B), dem Krümmungsradius r_5 , r_6 des fünften bzw. sechsten Spiegels zu

5

$$R \geq \tan \left(\arcsin (NA) \right) * \left[(S5 B) + (S5 S6) - \frac{1}{\frac{2}{r_6} - \frac{1}{r_5 + (S5 S6)}} \right]$$

10

gewählt wird. Ein Unterschreiten des Mindestradius führt bei Beibehalten der Bedingung eines obskurationsfreien Strahlverlaufes zu einem sprunghaften Anstieg der asphärischen Abweichung von der sphärischen Grundform der Spiegel, die auch als Asphärizität der Spiegel bezeichnet wird. Dies gilt insbesondere für den fünften Spiegel. Damit wird der Bereich, für den die paraxiale Näherung und die zuvor genannte Formel gilt, verlassen. Spiegel mit hoher Asphärizität sind aber fertigungstechnisch nur mit hohem Aufwand herzustellen.

15

20

Um die Winkelbelastung auf den Spiegeln gering zu halten, ist vorteilhafterweise vorgesehen, daß der Einfallswinkel des Hauptstrahles des Feldpunktes, der auf der Symmetrieachse in der Mitte des Objektfeldes liegt, auf allen Spiegel $< 18^\circ$ ist.

25

In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung weist das Projektionsobjektiv ein Zwischenbild auf, wobei das Zwischenbild vorteilhafterweise im Projektionsobjektiv in der Lichtrichtung nach dem vierten Spiegel ausgebildet wird.

30

In einer ersten Ausgestaltung der Erfindung ist der erste Spiegel konvex und alle sechs Spiegel sind asphärisch ausgebildet.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der erste Spiegel konkav und alle sechs Spiegel asphärisch ausgebildet.

5

Alternativ hierzu kann der erste Spiegel paraxial plan und alle sechs Spiegel asphärisch ausgebildet sein.

10

Eine gegenüber einer Ausgestaltung der Erfindung, bei der alle Spiegel asphärisch ausgebildet sind, besonders einfache Fertigbarkeit ergibt sich, wenn höchstens fünf Spiegel asphärisch sind.

15

Besonders bevorzugt ist es, wenn der Spiegel mit dem von der optischen Achse am entferntesten liegenden Nutzbereich, das ist in der Regel der vierte Spiegel, sphärisch ausgebildet ist.

20

Neben dem Projektionsobjektiv stellt die Erfindung auch eine Projektionsbelichtungsanlage zur Verfügung, wobei die Projektionsbelichtungsanlage eine Beleuchtungseinrichtung zur Beleuchtung eines Ringfeldes sowie ein Projektionsobjektiv gemäß der Erfindung umfasst.

25

Die Erfindung soll nachfolgend anhand der Ausführungsbeispiele beschrieben werden.

Es zeigen:

Figur 1: den Nutzbereich eines Spiegels

Figur 2: das Ringfeld in der Objektebene des Objektivs

30

Figur 3: die Definition des Bauraumes für zwei beliebige Spiegel des Projektionsobjektivs

Figur 4: eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit sechs asphärischen Spiegeln, wobei der erste Spiegel konvex ausgebildet ist

5 **Figur 5:** eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit sechs asphärischen Spiegeln, wobei der erste Spiegel konkav ausgebildet ist

10 **Figuren 6a- 6f** der Nutzbereich sämtlicher sechs Spiegel eine Projektionsobjektives gemäß Figur 4

15 **Figur 7:** eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit sechs asphärischen Spiegeln, wobei der erste Spiegel paraxial plan ausgebildet ist

20 **Figur 8:** eine vierte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit fünf asphärischen und einem sphärischen Spiegel, wobei der vierte Spiegel sphärisch ausgebildet ist

Figur 9: Bereich des fünften und sechsten Spiegels eines Sechsspiegel-Projektionsobjektives gemäß der Erfindung

25 **Figur 10:** der prinzipielle Aufbau einer Projektionsbelichtungsanlage mit einem erfindungsgemäßen Objektiv

In Figur 1 ist dargestellt, was in der vorliegenden Anmeldung unter Nutzbereich und Durchmesser des Nutzbereiches zu verstehen ist.

30

Figur 1 zeigt beispielhaft für ein ausgeleuchtetes Feld 1 auf einem Spiegel des Projektionsobjektives ein Feld in Nierenform. Eine derartige Form wird für den Nutzbereich bei Verwendung des erfindungsgemäßen Objektive in einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage erwartet. Der Hüllkreis 2 umschließt die Nierenform völlig und fällt an zwei Punkten 6, 8 mit dem Rand 10 der Nierenform zusammen. Der Hüllkreis ist stets der kleinste Kreis, der den Nutzbereich umfasst. Der Durchmesser D des Nutzbereiches ergibt sich dann aus dem Durchmesser des Hüllkreises 2.

In Figur 2 ist das Objektfeld 11 einer Projektionsbelichtungsanlage in der Objektebene des Projektionsobjektives dargestellt, das mit Hilfe des erfindungsgemäßen Projektionsobjektives in eine Bildebene, in der ein lichtempfindliches Objekt, beispielsweise ein Wafer angeordnet ist, abgebildet wird. Das Bildfeld in der Bildebene weist dieselbe Form auf wie das Objektfeld. Das Objekt- bzw. Bildfeld 11 hat die Gestalt eines Segmentes eines Ringfeldes. Das Segment weist eine Symmetrieachse 12 auf.

Des weiteren sind in Figur 2 die die Objektebene aufspannenden Achsen, nämlich die x-Achse und die y-Achse eingezeichnet. Wie aus Figur 2 zu entnehmen, verläuft die Symmetrieachse 12 des Ringfeldes 11 in Richtung der y-Achse. Gleichzeitig fällt die y-Achse mit der Scan-Richtung einer EUV-Projektionsbelichtungsanlage, die als Ringfeldscanner ausgelegt ist, zusammen. Die x-Richtung ist dann die Richtung, die innerhalb der Objektebene senkrecht auf der Scan-Richtung steht. Das Ringfeld weist einen sogenannten mittleren Ringfeldradius R auf, der durch den Abstand des Mittelpunktes 15 des Bildfeldes von der optischen Achse HA des Projektionsobjektives definiert ist.

In Figur 3 sind beispielhaft für das Gesamtsystem zwei Spiegelsegmente 20, 22 eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives gezeigt, wobei di

Spiegelsegmente 20, 22 mit den Nutzbereichen des Spiegels korrespondieren. Die Spiegelsegmente sind entlang einer optischen Achse 24 angeordnet. Wie aus Figur 3 des weiteren ersichtlich, ist jedem Nutzbereich 20, 22 eines Spiegels des Projektionsobjektives ein Bauraum 26, 28 zugeordnet. Unter der Tiefe T des Bauraumes wird in vorliegender Anmeldung die Ausdehnung des Bauraumes vom Mittelpunkt 30, 32 des Nutzbereichs 20, 22 eines jeden Spiegels parallel zur optischen Achse verstanden. Als Mittelpunkt des Nutzbereiches wird in vorliegender Anmeldung der Auftreffpunkt des Hauptstrahles CR des zentralen Feldpunktes des Objektfeldes auf den Nutzbereich des jeweiligen Spiegels verstanden. Wie in Figur 3 dargestellt sind die Spiegel im Projektionsobjektiv derart angeordnet, daß sich die Bauräume 26, 28 geometrisch nicht durchdringen.

In Figur 4 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen 6-Spiegel-Systems gezeigt, wobei die Größe des abzubildenden Objektes, das das Segment eines Ringfeldes darstellt und eine Symmetrieachse wie in Figur 2 dargestellt aufweist, in Richtung senkrecht zur Symmetrieachse mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist. Das abzubildende Objekt befindet sich in der Objektebene 100 des in der Figur 4 dargestellten Objektives. In der Objektebene 100 wird als Objektfeld in vorliegendem Beispiel ein Ringfeldsegment ausgebildet. Desweiteren ist in der Objektebene das auf eine lichtempfindliche Schicht abzubildende Objekt, das in der Lithographie auch als Retikel bezeichnet wird, angeordnet.

Die Ebene, in die das Objekt 100 durch das erfindungsgemäße Projektionsobjektiv abgebildet wird, ist die Bildebene 102, in der beispielsweise ein Wafer angeordnet sein kann. Das erfindungsgemäße Projektionsobjektiv umfaßt einen ersten Spiegel S1, einen zweiten Spiegel S2, einen dritten Spiegel S3, einen vierten Spiegel S4, einen fünften Spiegel S5 sowie einen sechsten Spiegel S6. Bei dem in Figur 4

dargestellten Ausführungsbeispiel sind sämtliche sechs Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 und S6 als asphärische Spiegel ausgebildet. Bei dem ersten Spiegel S1 handelt es sich um einen Konvex-Spiegel.

5 Die Blende B ist bei dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 auf dem zweiten Spiegel S2 angeordnet. Das System ist zur optischen Achse HA zentriert und bildseitig, d.h. in der Bildebene 102 telezentrisch. Unter bildseitiger Telezentrie versteht man, daß der Hauptstrahl CR unter einem Winkel von nahe oder ungefähr 90° auf die Bildebene 102 trifft.

10

Um die Lichtverluste und die beschichtungsinduzierten Wellenfrontaberrationen innerhalb des Spiegelsystems möglichst gering zu halten, ist der Auftreffwinkel des Hauptstrahles CR des zentralen Feldpunktes auf die jeweilige Spiegeloberfläche stets kleiner als 18° . In

15 Figur 4 ebenfalls eingezeichnet sind die Bauräume B1, B2, B3, B4, B5 und B6 der Nutzbereiche N1, N2, N3, N4, N5 und N6 der jeweiligen Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 und S6.

20

Wie aus Figur 4 deutlich zu erkennen, ist das Gesamtobjektiv derart aufgebaut, daß alle Bauräume B1, B2, B3, B4, B5 und B6 in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse 12 des in der Ebene 100 liegenden Objektfeldes ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird. Zur leichteren

25 Lesbarkeit ist in Figur 4 ein Koordinatensystem x, y, z eingezeichnet. Die optische Achse des Objektives verläuft in z-Richtung, das Objektfeld liegt in der x-y-Ebene und die Symmetrieachse des Objektfeld 100 weist in y-Richtung.

25

Wie aus Figur 4 hervorgeht sind die Bauräume aller Nutzbereiche in

30 Richtung der Symmetrieachse 12 des Objektfeldes ausdehnbar. Dies stellt

sich r, daß die Spiegel von wenigstens einer Seite des Objektives her zugänglich sind und beispielsweise eingefast und montiert werden können.

Des weiteren handelt es sich bei dem Ausführungsbeispiel 1 gemäß Figur 4 um ein System mit Zwischenbild Z. Das Zwischenbild Z wird geometrisch nach dem ersten Spiegel S1 zwischen viertem und fünftem Spiegel S4, S5 ausgebildet. Durch das Zwischenbild Z wird das System gemäß Figur 4 in zwei Teilsysteme, ein erstes Teilsystem umfassend die Spiegel S1, S2, S3 und S4 sowie in ein zweites Teilsystem umfassend die Spiegel S5 und S6 geteilt.

Der Bauraum B1 bis B4 und B6 der Spiegel S1 bis S4 und S6 beträgt mindestens 50 mm, der Bauraum B5 des fünften Spiegels mindestens ein Drittel des Durchmessers des Nutzbereichs des fünften Spiegels, so daß ein freier Arbeitsabstand zwischen dem wafernächsten fünften Spiegel S5 und der Bildebene 102 von mindestens 12 mm garantiert wird.

Die Code V-Daten des ersten Ausführungsbeispieles gemäß Figur 4 sind in Tabelle 1, die im Anhang wiedergegeben ist, angegeben. Hierbei bezeichnet die Element-Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 sowie S6.

Die bildseitige numerische Apertur des Systems gemäß Ausführungsbeispiel 1 beträgt 0,25.

In Figur 5 ist ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Gleiche Bauteile wie in Figur 4 sind mit denselben Bezugsziffern belegt. Wiederum sind alle sechs Spiegeloberflächen asphärisch, im Gegensatz zur Ausführungsform gemäß Figur 4 ist jedoch der erste Spiegel S1 nicht konvex, sondern konkav ausgebildet.

Die Daten des Systems sind in der in Tabelle 2 im Anhang der Anmeldung wiedergegebenen Code V-Tabelle angegeben. Die numerische Apertur des Projektionsobjektives gemäß Figur 5 beträgt wie schon im Falle der ersten Ausführungsform gemäß Figur 4 $NA = 0,25$.

5

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5 sind erfindungsgemäß die Durchmesser D der Nutzbereiche aller im Objektiv angeordneten Spiegel kleiner als 300 mm, wobei das abzubildende Objekt das Segment eines Ringfeldes ist, wie in Figur 2 dargestellt.

10

Die Nutzbereiche in der x-y-Ebene der jeweiligen Spiegel des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß Figur 5 ist in den Figuren 6a bis 6f gezeigt. In allen Abbildungen eingezeichnet ist das x-y-Koordinatensystem, wie durch die Objektebene definiert. Hierbei bezeichnet die y-Richtung die Richtung in Richtung der Scan-Richtung eines Ringfeldscanners und die x-Richtung die Richtung senkrecht zur Scan-Richtung.

15

20

Wie aus Figur 6a hervorgeht, ist der Nutzbereich N1 auf dem Spiegel S1 im wesentlichen nierenförmig und weist einen Durchmesser D wie in Figur 1 definiert, von 145,042 mm auf. Der Durchmesser des Nutzbereiches N2 auf dem Spiegel S2 ist im wesentlichen kreisförmig, der Durchmesser beträgt 157,168 mm gemäß Figur 6b.

25

Beim Spiegel S3 ist der Nutzbereich N3 wiederum nierenförmig, der Durchmesser D beträgt 102,367 mm gemäß Figur 6c und beim Spiegel S4 weist der Nutzbereich N4 gemäß Figur 6d einen Durchmesser von 222,497 mm auf.

30

Die Nutzbereiche N5 und N6 gemäß den Figuren 6e und 6f auf den Spiegeln S5 und S6 sind im wesentlichen kreisförmig, der Durchmesser D

des Nutzbereiches N5 beträgt 83,548 mm und der Durchmesser D des Nutzbereiches N6 270,054 mm.

5 Erfindungsgemäß ist somit der Durchmesser sämtlicher Nutzbereiche N1 bis N6 der Ausführungsform des Projektionsobjektives gemäß Figur 5 kleiner als 300 mm.

10 In Figur 7 ist eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit sechs asphärischen Spiegeln gezeigt. Wiederum sind für gleiche Bauteile wie in den Figuren 4 und 6 dieselben Bezugsziffern verwendet. Die Daten der dritten Ausführungsform gemäß Figur 7 sind in der im Anhang wiedergegebenen Tabelle 3 im Code V-Format angegeben. Die numerische Apertur des Systems gemäß Figur 7 beträgt $NA=0,25$. Der erste Spiegel S1 des Ausführungsbeispiels in Figur 15 7 ist paraxial plan ausgebildet. Hierunter versteht man in der vorliegenden Anmeldung, daß die Grundkrümmung des Spiegels S1 in der Nähe der optischen Achse HA identisch Null ist.

20 Ein aus Fertigungsgesichtspunkten besonders vorteilhaftes 6-Spiegel-System zeigt Figur 8. Bei dem System gemäß Figur 8 beträgt die numerische Apertur 0,23, der vierte Spiegel ist ein sphärischer Spiegel, was unter Fertigungsgesichtspunkten sehr vorteilhaft ist, da sphärische Flächen leichter als asphärische Flächen zu bearbeiten sind und der vierte Spiegel S4 der Spiegel mit dem am weitesten von der optischen Achse entfernten 25 Nutzbereich ist.

Die Daten des Systems gemäß Figur 8 sind in Tabelle 4 im Anhang im Code V-Format wiedergegeben.

30 Für die relativ geringen Abmessungen der Nutzbereiche der Spiegel, insb. sonder des vierten Spiegels, ist die Lage des vierten Spiegels

geometrisch zwischen drittem und zweitem bzw. erstem und zweitem Spiegel im Projektionsobjektiv verantwortlich.

Die Daten betreffend die Lage des vierten Spiegels in bezug auf den zweiten und ersten Spiegel bzw. den zweiten und dritten Spiegel werden durch nachfolgende Bedingungen beschrieben:

$$0,1 < \frac{(S_4, S_1)}{(S_2, S_1)} < 0,9 \quad (1)$$

$$0,3 < \frac{(S_3, S_4)}{(S_2, S_3)} < 0,9 \quad (2)$$

Bevorzugt gilt für Bedingung (2):

$$0,4 < \frac{(S_3, S_4)}{(S_2, S_3)} < 0,9 \quad (2a)$$

Diese Bedingungen sind für die vier Ausführungsbeispiele in den nachfolgenden Tabellen wiedergegeben.

Tabelle 5: Daten zur Bedingung (1)

Ausführungs- beispiel	Eigenschaft	(S4S1)/ (S2S1)
1 = Figur 4	M1 konvex	0.14
2 = Figur 5	M1 konkav	0.35
3 = Figur 7	M1 plan	0.19
4 = Figur 8	NA = 0.23, 5 Asphären	0.67

Tabelle 6: Daten zur Bedingung (2)

Ausführungs- beispiel	Eigenschaft	(S3S4)/ (S2S3)
1 = Figur 4	M1 konvex	0.31
2 = Figur 5	M1 konkav	0.44
3 = Figur 7	M1 plan	0.34
4 = Figur 8	NA = 0.23, 5 Asphären	0.69

Der Durchmesser der Nutzbereiche ist insbesondere deswegen ein wichtiger Parameter, da sie die Abmessungen der Objektivkammer festlegen. Große Nutzbereiche und damit große Spiegel beanspruchen einen sehr großen Bauraum, was unter dem Gesichtspunkt der Evakuierung eines größeren UHV-Systems nachteilhaft ist. Ein weiterer Nachteil großer Spiegel ist deren größere Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Schwingungen, da ihre Eigenfrequenz kleiner ist als bei kleineren Spiegeln. Ein weiterer Vorteil von Spiegeln mit geringen Abmessungen liegt darin, daß die Asphärisierung und Beschichtung der Substrate in kleineren UHV-Bearbeitungskammern erfolgen kann.

Da die Beschichtung der Spiegelsubstrate mit den Vielfachschichtsystemen zu Schichtspannungen führen, können insbesondere am Rand des Substrates Deformationen auftreten. Damit diese sich nicht in den Nutzbereich des Spiegels fortsetzen, ist es notwendig, außerhalb des Nutzbereiches einen Mindestüberlauf vorzusehen, innerhalb dessen die Deformationen abklingen können. Der Randbereich der einzelnen Spiegel in den Ausführungsbeispielen 1 bis 4 ist in nachfolgender Tabelle 7 wiedergegeben.

Tabelle 7: Daten zu den Randbereichen der Spiegel S1 bis S6

Spiegel	A1 = Figur 4	A2 = Figur 5	A3 = Figur 7	A4 = Figur 8
S1	13 mm	21 mm	16 mm	2 mm
S2	11 mm	11 mm	8 mm	8 mm
S3	22 mm	28 mm	26 mm	8 mm
S5	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
S6	5 mm	6 mm	5 mm	2 mm

Wie hieraus zu ersehen ist, beträgt der Randbereich bei den Ausführungsformen gemäß Figur 4, 5 und 7 für jeden Spiegel mehr als 4 mm, was für die fassungstechnische Berücksichtigung von Schichtspannungen besonders vorteilhaft ist.

In Figur 9 ist die Anordnung von fünftem und sechstem Spiegel S5, S6 bei einer vorteilhaften Ausführungsform eines Projektionsobjektiv gemäß der Erfindung gezeigt.

Gemäß Figur 9 trifft das abbildende Strahlbündel 200 auf die Bildebene 102, in der beispielsweise ein Wafer angeordnet ist, telezentrisch auf. Der sechste Spiegel S6 ist konkav geformt. Der fünfte Spiegel S5 liegt zwischen dem sechsten Spiegel S6 und der Bildebene 102. Bei den erfindungsgemäßen Projektionsobjektiven sind alle Spiegel S1, S2, S3, S4, S5, S6 zwischen Objektebene 100 und Bildebene 102 angeordnet. Fordert man einen abschattungsfreien Strahlengang in dem erfindungsgemäßen Projektionsobjektiv, so existieren im in Figur 9 gezeigten bildseitigen Objektivteil mit den Spiegeln S5 und S6 zwei kritische Bereiche für eine abschattungsfrei Strahlführung.

Der eine Bereich liegt am oberen Rand 202 des Nutzbereiches des fünften Spiegels S5. Die Strahlführung muß so konstruiert sein, daß die unteren

20

Randstrahlen 204 des Strahlbündels 200 oberhalb des Nutzbereiches N5 dieses Spiegels S5 verlaufen und auf die Bildebene 102 treffen. Bezeichnet R den Ringfeldradius und (S5 B) den Abstand zwischen S5 und der Bildebene 102, so ist der Abstand der unteren Randstrahlen 204 von der optischen Achse HA durch die Beziehung

$$y = R - (S5 B) * \tan (\arcsin (NA))$$

gegeben, wobei NA die numerische Apertur an der Austrittspupille bezeichnet.

Die obere Grenze des Nutzbereiches N5 wird durch den Auftreffpunkt der oberen Randstrahlen 206 des Strahlbündels 200 auf den fünften Spiegel S5 festgelegt. Unter Verwendung der Variablen

r_6 : Krümmungsradius von S6

(S5 S6): (positiver) Abstand zwischen S5 und S6

liefert die Anwendung der Schnittweitengleichung auf den sechsten Spiegel S6 für den Abstand y' des oberen Randes 202 des Nutzbereiches N% des fünften Spiegels von der optischen Achse HA'

$$y' = \left[\frac{2}{r_6} - \frac{1}{(S5 B) + (S5 S6) + \frac{R}{\tan(\arcsin(NA))}} \right] (S5 S6)$$
$$\tan \left[\arcsin(NA) + 2 \arcsin \left(\frac{NA}{r_6} * \left((S5 B) + (S5 S6) - r_6 + \frac{R}{\tan(\arcsin(NA))} \right) \right) \right]$$

Um einen obskurationsfreien Strahlverlauf am fünften Spiegel S5 zu erreichen, muß dann gelten:

$$\Delta y = y - y' \geq 0$$

Der andere kritische Bereich liegt am unteren Rand von S6. Um an dieser Stelle Abschattungsfreiheit in paraxialer Näherung zu gewährleisten, ergibt sich nach zweimaliger Anwendung der Schnittweitengleichung auf S5 und S6 für den Ringfelddradius R des Bildfeldes in der Bildebene 102:

$$R \geq \tan \left(\arcsin (NA) \right) * \left[(S5 B) + (S5 S6) - \frac{1}{\frac{2}{r_6} - \frac{1}{r_5 + (S5 S6)}} \right]$$

Wählt man r_6 , r_5 , $(S_5 B)$ sowie $(S_5 S_6)$ fest und zwar

$$\begin{aligned} r_6 &= 535,215 \text{ mm}; & r_5 &= 594,215 \text{ mm}; \\ (S5 B) &= 44,083 \text{ mm}; & (S5 S6) &= 437,186 \text{ mm}, \end{aligned}$$

so ergibt sich folgende Tabelle 5 aus obiger Formel für den Ringfelddradius R in Abhängigkeit von der Apertur unter der Randbedingung obskurationsfreier Strahlführung am fünften Spiegel gemäß den Formeln für y' und Δy :

Tabelle 5:

NA	0,15	0,20	0,25	0,30
R in [mm]	18,191	24,475	30,958	37,707

Wie aus Tabelle 5 zu erkennen, hat eine große numerische Apertur NA an der Austrittspupille einen großen Ringfeldradius zur Folge.

Bei vorgegebenem Ringfeldradius ist eine Aperturvergrößerung bei
5 koaxialen 6-Spiegel-Objektiven nur bis zu einem bestimmten Wert möglich.
Oberhalb dieses Wertes beobachtet man einen nahezu sprunghaften
Anstieg der Asphärizität auf dem fünften Spiegel, welcher zu Problemen in
Asphärenfertigung und -meßtechnik sowie Problemen bei der Korrektur des
Objektives führt.

10 (S5 B) ist mit dem sogenannten Arbeitsabstand des Objektives am Wafer
gleichzusetzen, der eine Mindestgröße nicht unterschreiten darf. Eine
Verringerung des Ringfeldradius durch eine Verkleinerung von (S5 B) ist
also nur bis zur Erreichung des Mindestabstandes möglich.

15 Eine Verkleinerung des Abstandes (S5 S6) führt zwar zu kleineren
Ringfeldradien, vergrößert aber andererseits die Einfallswinkel auf dem
fünften Spiegel S5. Die großen Einfallswinkel auf S5 wiederum erlauben nur
mit sehr großem Aufwand die Herstellung von Multischichtsystem mit
20 optimalem Reflexionsvermögen. Eine Verkleinerung von r_5 führt zu
denselben Nachteilen wie die Verkleinerung des Abstandes (S5 S6), da
auch eine derartige Verkleinerung mit großen Einfallswinkeln auf S5
einhergeht.

25 Eine Vergrößerung von r_6 liefert zwar kleinere Ringfeldradien, allerdings
wird die Obskurationsfreiheit am fünften Spiegel verletzt.

In Figur 10 ist eine Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie
mit einem erfindungsgemäßen 6-Spiegel-Projektionsobjektiv 200 dargestellt.
30 Das Beleuchtungssystem 202 kann wie beispielsweise in d r EP
99106348.8 mit dem Titel "Beleuchtungssystem, insbesondere für die EUV-

Lithographie" oder US-Serial No 09/ 305,017 mit dem Titel "Illumination system particularly for EUV-Lithography" beschrieben, deren Offenbarungsgehalt vollumfänglich in die vorliegende Anmeldung mitaufgenommen wird, ausgebildet sein. Ein derartiges

5 Beleuchtungssystem umfasst eine EUV-Lichtquelle 204. Das Licht der EUV-Lichtquelle wird vom Kollektorspiegel 206 gesammelt. Mit Hilfe eines ersten Spiegels 207 umfassend Rasterelemente - sogenannte Feldwaben - und eines zweiten Spiegels 208 umfassend Rasterelemente - sogenannte Pupillenwaben - sowie eines Spiegels 210 wird das Retikel 212 beleuchtet.
10 Das vom Retikel 212 reflektierte Licht wird mittels des erfindungsgemäßen Projektionsobjektives auf einen Träger 214 umfassend eine lichtempfindliche Schicht abgebildet.

15 Mit der Erfindung wird somit erstmals ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln angegeben, das sich durch Nutzbereiche mit geringen Abmessungen auf allen Spiegeln auszeichnet und insoweit ein aus konstruktionstechnischer und fertigungstechnischer Sicht besonders vorteilhaftes, kompaktes Projektionsobjektiv darstellt.

20

Bezugszeichenliste

	Z:	Hüllkreis
5	6, 8:	Punkte, an denen der Hüllkreis mit dem nierenförmig ausgeleuchteten Feld zusammenfällt
	10:	Rand des nierenförmig ausgeleuchteten Feldes
	11:	Objektfeld
10	12:	Symmetrieachse des Ringfeldes
	15:	Mittelpunkt des Objekt- bzw. Bildfeldes
	20, 22:	Spiegelsegmente
	26, 28:	Bauraum
15	30, 32:	Mittelpunkt des Nutzbereiches
	100:	Objektebene
	102:	Bildebene
20	200:	abbildendes Strahlbündel
	202:	oberer Rand des Nutzbereiches N5 an S5
	204:	untere Randstrahlen
	206:	obere Randstrahlen
25	S1:	erster Spiegel
	S2:	zweiter Spiegel
	S3:	dritter Spiegel
	S4:	vierter Spiegel
	S5:	fünfter Spiegel
30	S6:	sechster Spiegel
	B1, B2, B3, B4, B5, B6:	den Spiegeln zugeordnete Bauräume

N1, N2, N3, N4, N5, N6: an den Spiegeln zugeordnete Nutzbereiche

x, y, z: Koordinaten des Koordinatensystems in der Objekt- und Bildebene

5 HA: optische Achse des Projektionsobjektives

NA: numerische Apertur an der Austrittspupille

R: Ringfeldradius

CR: Hauptstrahl

B: Blende

10 Z: Zwischenbild

D: Durchmesser des Nutzbereiches

15

Anhang: Tabellen 1 - 4 Code V - Objektivdaten

Tabelle 1: Ausführungsbeispiel 1 (Figur 4)

5	ELEMENT NUMMER	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART
	OBJEKT	INF	743.3276		
	1	A(1)	-557.1863	210.8986	REFL
			APERTURBLENDEN	177.1640	
			0.0000		
	2	A(2)	.702.9968	177.3847	REFL
	3	A(3)	-221.1310	191.0743	REFL
	4	A(4)	787.9929	426.0706	REFL
	5	A(5)	-436.7697	110.1796	REFL
	6	A(6)	480.7697	310.6813	REFL
10	BILD	INF		70.5007	

ASPHÄRISCHE KONSTANTEN

$$Z = \frac{(CURV)^2}{1 + (1 - (1 + K)(CURV)^2)^{1/2}} + (A)Y^4 + (B)Y^6 + (C)Y^8 + (D)Y^{10} + (E)Y^{12} + (F)Y^{14} + (G)Y^{16} + (H)Y^{18} + (J)Y^{20}$$

15

ASPHÄRE	CURV	K	A	B	C	D
		E	F	G	H	J
A(1)	0.00006144	0.000000 1.87256E-29	5.48969E-10 0.00000E+00	-4.47710E-15 0.00000E+00	6.93597E-20 0.00000E+00	-1.61832E-24 0.00000E+00
A(2)	0.00092955	0.000000 -7.88639E-30	-4.50667E-11 0.00000E+00	-3.63055E-16 0.00000E+00	-3.52050E-21 0.00000E+00	7.46570E-26 0.00000E+00
20 A(3)	0.00184106	0.000000 1.64447E-27	-3.98337E-10 0.00000E+00	-2.92857E-15 0.00000E+00	8.46286E-19 0.00000E+00	-5.98614E-23 0.00000E+00
A(4)	0.00193867	0.000000 -1.71616E-31	-3.53491E-12 0.00000E+00	7.43877E-17 0.00000E+00	-5.36969E-22 0.00000E+00	2.36533E-26 0.00000E+00
A(5)	0.00179551	0.000000 -9.96256E-26	5.44569E-09 0.00000E+00	1.45719E-13 0.00000E+00	-5.07132E-18 0.00000E+00	1.13331E-21 0.00000E+00
A(6)	0.00186905	0.000000 4.44608E-32	6.69863E-11 0.00000E+00	3.06114E-16 0.00000E+00	1.29123E-21 0.00000E+00	2.82784E-27 0.00000E+00

25

REFERENZWELLENLÄNGE = 13.4 NM
 ABBILDUNGSMASSTAB = 0.25
 BILDSEITIGE APERTUR = 0.25

30

28

Tabelle 3: Ausführungsbeispiel 3 (Figur 7)

ELEMENT NUMMER	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART
5	OBJEKT	767.2557		
1	INF	-555.7033	216.0671	REFL
	A(1)	APERTURBLENDE	173.9832	
		0.0000		
2	A(2)	682.2766	174.2476	REFL
3	A(3)	-233.6859	188.2262	REFL
4	A(4)	794.6148	428.4357	REFL
5	A(5)	-436.8293	110.5239	REFL
6	A(6)	480.8400	310.5587	REFL
BILD	INF		70.4765	

10

ASPHÄRISCHE KONSTANTEN

$$Z = \frac{(CURV)Y^2}{1 + (1 - (1 + K)(CURV)Y^2)^{1/2}} + (A)Y^4 + (B)Y^6 + (C)Y^8 + (D)Y^{10} + (E)Y^{12} + (F)Y^{14} + (G)Y^{16} + (H)Y^{18} + (J)Y^{20}$$

15

ASPHÄRE	CURV	K E	A F	B G	C H	D J
A(1)	0.00000000	0.000000 2.03931E-29	5.67634E-10 0.00000E+00	-4.28505E-15 0.00000E+00	6.16577E-20 0.00000E+00	-1.42715E-24 0.00000E+00
A(2)	0.00092352	0.000000 -7.88639E-30	-4.50667E-11 0.00000E+00	-3.63055E-16 0.00000E+00	-3.52050E-21 0.00000E+00	7.46370E-26 0.00000E+00
A(3)	0.00277871	0.000000 1.08438E-27	-3.26329E-10 0.00000E+00	-7.02528E-16 0.00000E+00	5.33788E-19 0.00000E+00	-3.92007E-23 0.00000E+00
A(4)	0.00188296	0.000000 -6.94542E-31	-9.51406E-12 0.00000E+00	5.06179E-16 0.00000E+00	-9.93523E-21 0.00000E+00	1.33054E-25 0.00000E+00
A(5)	0.00185628	0.000000 -1.05073E-25	5.15785E-09 0.00000E+00	1.54832E-13 0.00000E+00	-5.20812E-18 0.00000E+00	1.16863E-21 0.00000E+00
A(6)	0.00186897	0.000000 6.23447E-32	6.62264E-11 0.00000E+00	2.99098E-16 0.00000E+00	1.29774E-21 0.00000E+00	1.07497E-27 0.00000E+00

25

REFERENZWELLENLÄNGE = 13.4 NM
 ABBILDUNGSMASSTAB = 0.25
 BILDSEITIGE APERTUR = 0.25

30

Patentansprüche

1. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen,
5 vorzugsweise ≤ 193 nm mit einer Eintrittspupille und einer Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse aufweist und die Ausdehnung mindestens 20,
10 bevorzugt 25 mm ist,
- 1.1 einem ersten (S1), einem zweiten (S2), einem dritten (S3), einem vierten (S4), einem fünften (S5) und einem sechsten Spiegel (S6) in zentrierter Anordnung zu einer optischen Achse, wobei
- 1.2 jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die
15 Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, auftreten
dadurch gekennzeichnet, daß
- 1.3 für den Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels in Abhängigkeit von der
20 numerischen Apertur des Objektives an der Austrittspupille gilt:

Durchmesser des Nutzbereiches ≤ 1200 mm * NA

2. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach Anspruch 1,
25 dadurch gekennzeichnet, daß
die numerische Apertur an der Austrittspupille größer als 0,1,
bevorzugt größer als 0,2, besonders bevorzugt größer als 0,23,
und
der Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten,
30 vierten, fünften und sechsten Spiegels ≤ 300 mm ist.

3. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß
- 5 der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel jeweils einen rückwärtigen Bauraum aufweist, der parallel zur optischen Achse gemessen von der Spiegelvorderseite im Nutzbereich eine Tiefe aufweist, wobei die Tiefe jeweils des ersten, zweiten, dritten, vierten und sechsten Bauraumes mindestens 50 mm und die Tiefe des Bauraumes des fünften Spiegels größer als 1/3 des Wertes des
- 10 Durchmessers des fünften Spiegels ist, wobei sich die jeweiligen Bauräume nicht durchdringen.
4. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
- 15 dadurch gekennzeichnet, daß
- daß alle Bauräume in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird.
- 20 5. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß
- der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel einen Randbereich umlaufend um den Nutzbereich umfaßt und der Randbereich mehr als 4 mm beträgt, wobei die Lichtführung im
- 25 Objektiv obskurationsfrei erfolgt.
6. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
- 30 der Nutzber ich des vierten Spiegels geometrisch zwischen zweitem Spiegel und der Bild bene angeordnet ist.

7. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
der vierte Spiegel geometrisch zwischen drittem und zweitem Spiegel angeordnet ist.

5

8. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
der vierte Spiegel geometrisch zwischen erstem und zweitem Spiegel angeordnet ist.

10

9. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von viertem und erstem Spiegel (S4 S1) zum Abstand von zweitem und erstem Spiegel (S2 S1) im Bereich

15

$$0,1 < \left(\frac{S4 \ S1}{S2 \ S1} \right) < 0,9$$

liegt.

20

10. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von drittem und zweitem Spiegel (S2 S3) zum Abstand von viertem zu drittem Spiegel (S4 S3) im Bereich

25

$$0,3 < \left(\frac{S3 \ S4}{S2 \ S3} \right) < 0,9$$

30

liegt.

11. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
- In Abhängigkeit von der numerischen Apertur NA an der Austrittspupille, dem Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von fünftem und sechstem Spiegel (S5 S6), dem Abstand des Spiegelscheitels des fünften Spiegels von der Bildebene (S5 B), dem Krümmungsradius r_5 , r_6 des fünften und sechsten Spiegels für den mittleren Ringfeldradius R gilt:

$$R \geq \tan (\arcsin (NA)) \cdot$$

$$\left[(S5 B) + (S5 S6) - \frac{1}{\frac{2}{r_6} - \frac{1}{r_5 + (S5 S6)}} \right]$$

12. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß
- der Einfallswinkel des Hauptstrahles des Feldpunktes, der auf der Symmetrieachse in der Mitte des Objektfeldes liegt auf allen Spiegel $< 16^\circ$ ist.
13. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß
- im Projektionsobjektiv in der Lichtrichtung nach dem vierten Spiegel (S4) ein Zwischenbild ausgebildet wird.
14. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß
- eine Blende (B) im Lichtweg bzw. Strahlengang auf dem zweiten Spiegel (S2) angeordnet ist.

15. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß
der erste Spiegel konvex und der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.
- 5
16. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß
der erste Spiegel paraxial flach und der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.
- 10
17. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß
der erste Spiegel konkav und der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.
- 15
18. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß
sämtliche Spiegel asphärisch ausgebildet sind.
- 20
19. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß
höchstens fünf Spiegel asphärisch sind.
- 25
20. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß
der vierte Spiegel sphärisch ausgebildet ist.
- 30
21. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß
der zweite bis sechste Spiegel (S2 S6) in der Reihenfolge konkav - konvex - konkav - konvex - konkav ausgebildet ist.

22. Mikrolithographie-Projektionsobjektiveinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß das Objektiv bildseitig telezentrisch ist.
- 5 23. Projektionsbelichtungsanlage, dadurch gekennzeichnet, daß die Projektionsbelichtungsanlage eine Beleuchtungseinrichtung zur Beleuchtung eines Ringfeldes sowie ein Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 22 umfasst.
- 10 24. Verfahren zur Chipherstellung mit einer Projektionsbelichtungsanlage gemäß Anspruch 23.

6-Spiegel-Mikrolithographie-Projektionsobjektiv

Zusammenfassung

- 5 Die Erfindung betrifft ein Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen, vorzugsweise ≤ 193 nm mit einer Eintrittspupille und einer Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse
- 10 aufweist und die Ausdehnung mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist,
- einem ersten (S1), einem zweiten (S2), einem dritten (S3), einem vierten (S4), einem fünften (S5) und einem sechsten Spiegel (S6) in zentrierter Anordnung zu einer optischen Achse, wobei
 - 15 jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, auftreten.

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß

20 in Abhängigkeit der numerischen Apertur NA der Austrittspupille der Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels $\leq 1200 \text{ mm} \cdot NA$ ist.

(Figur 5)

P 15380 EP

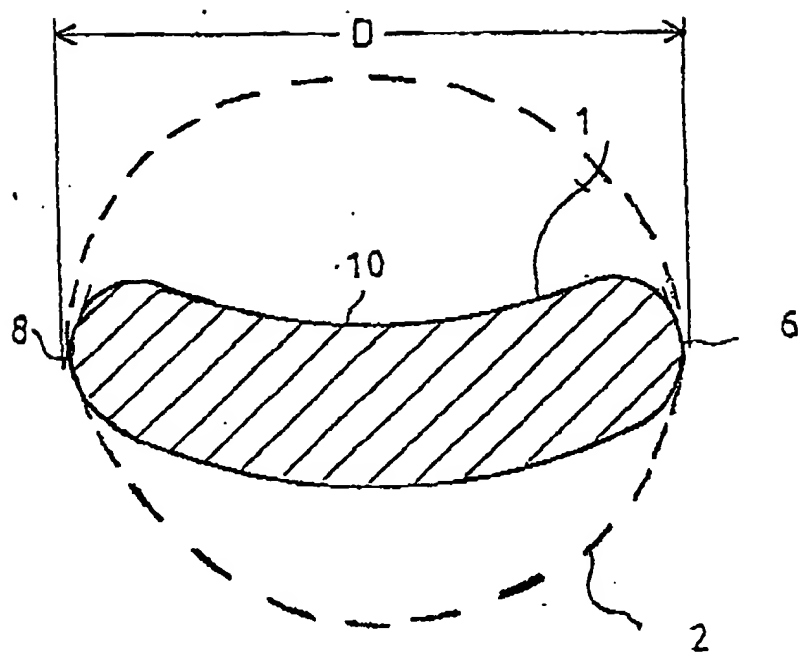
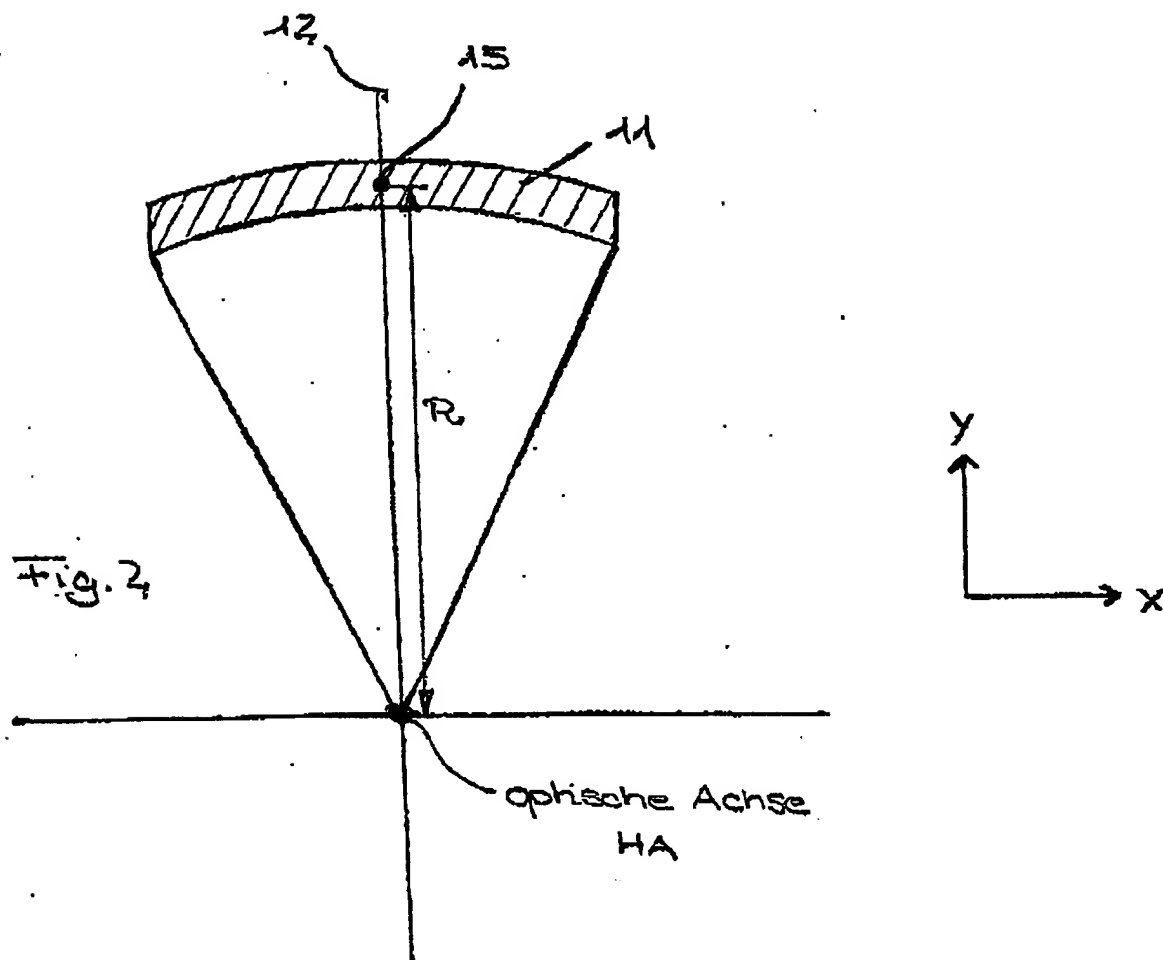


FIG. 1



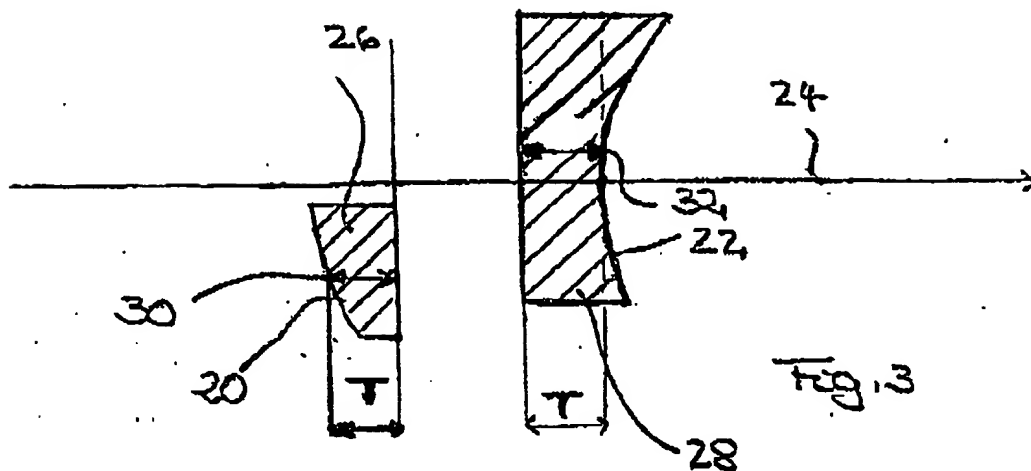
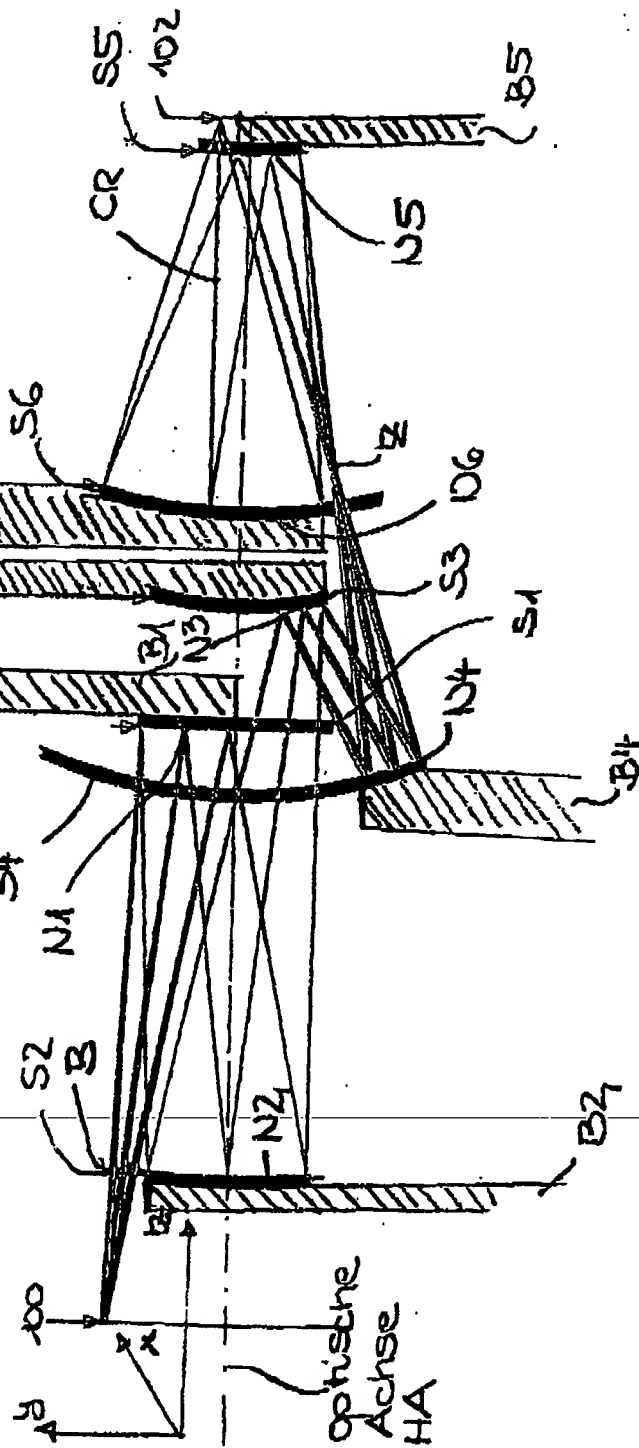
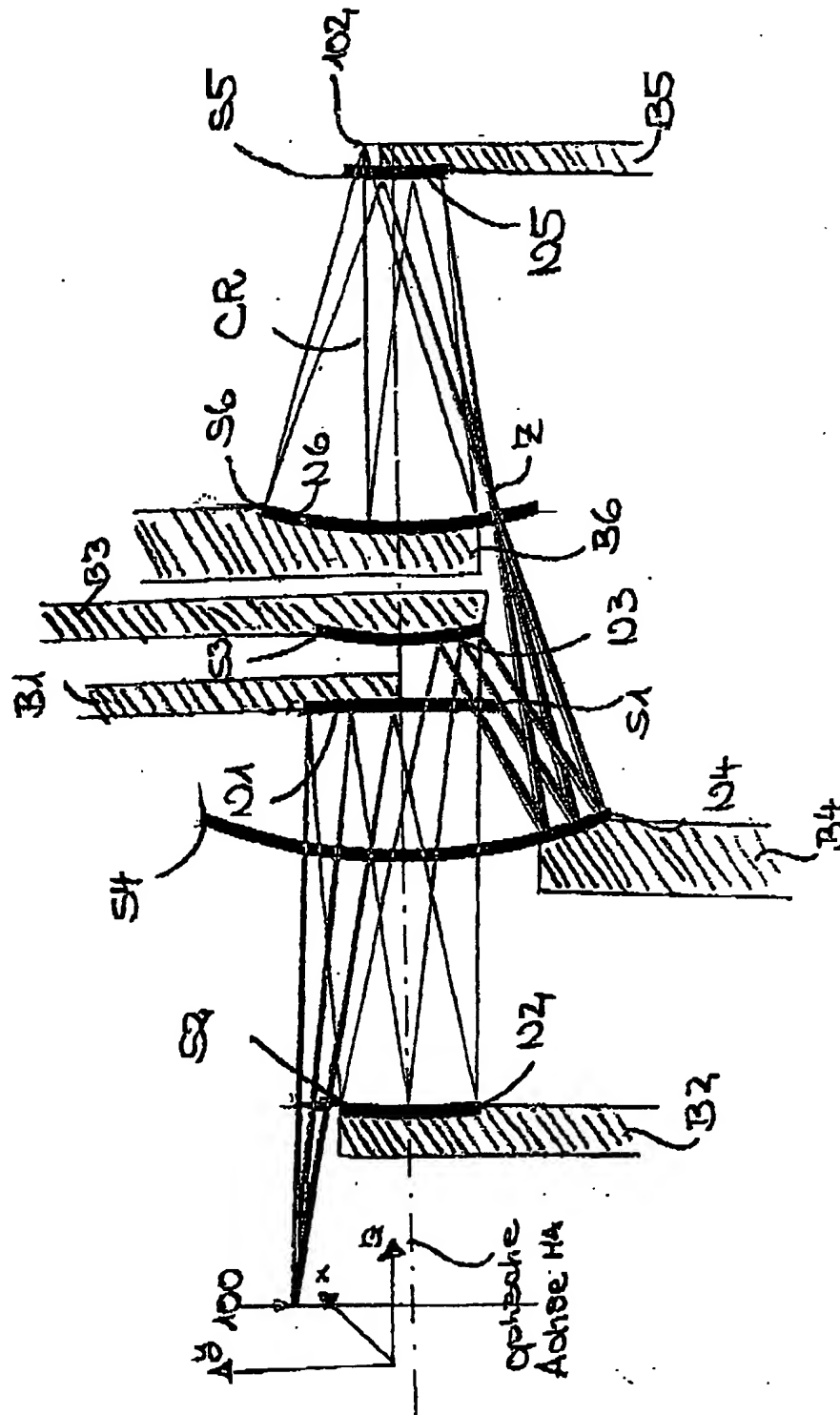


FIG. 4



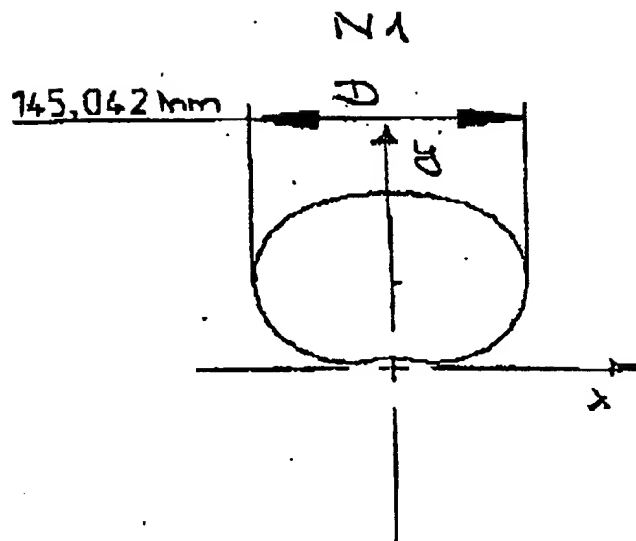
208.33 mm

Fig. 5



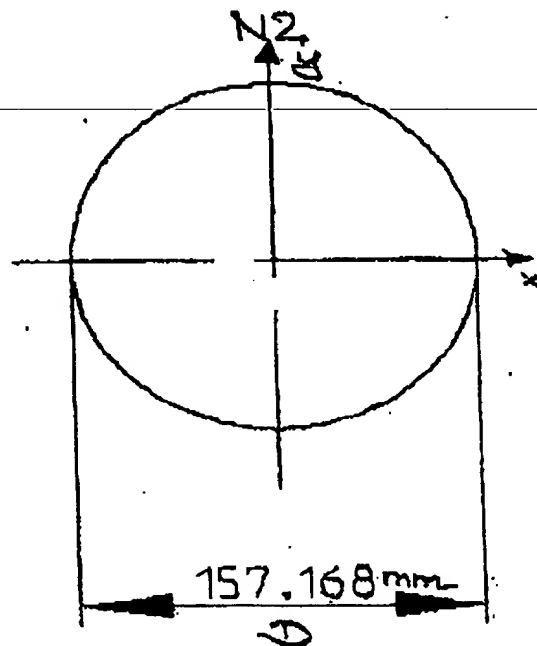
208.33 mm

S1



S2

Fig. 6b



S3

N3

Fig. 6a

102.367 mm

D

+

N4

Fig. 6d

222.497 mm

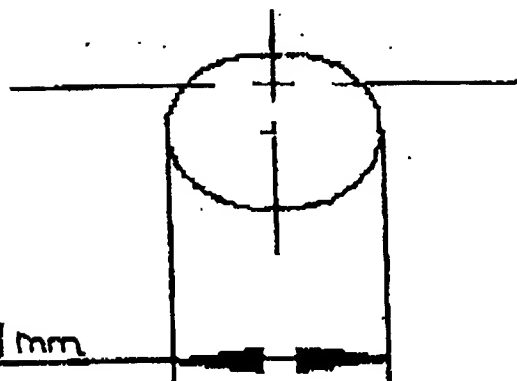
D

S5

N5

Fig. 6e

83.548 mm

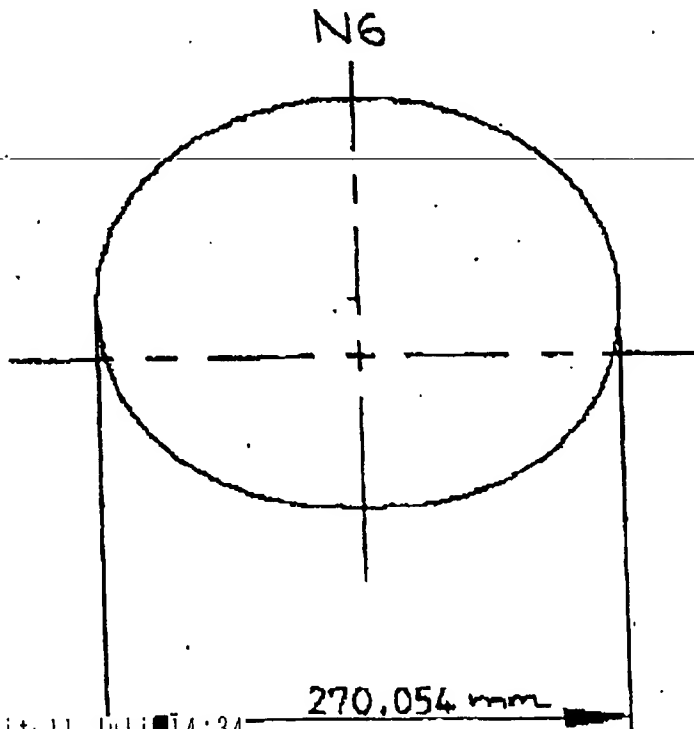


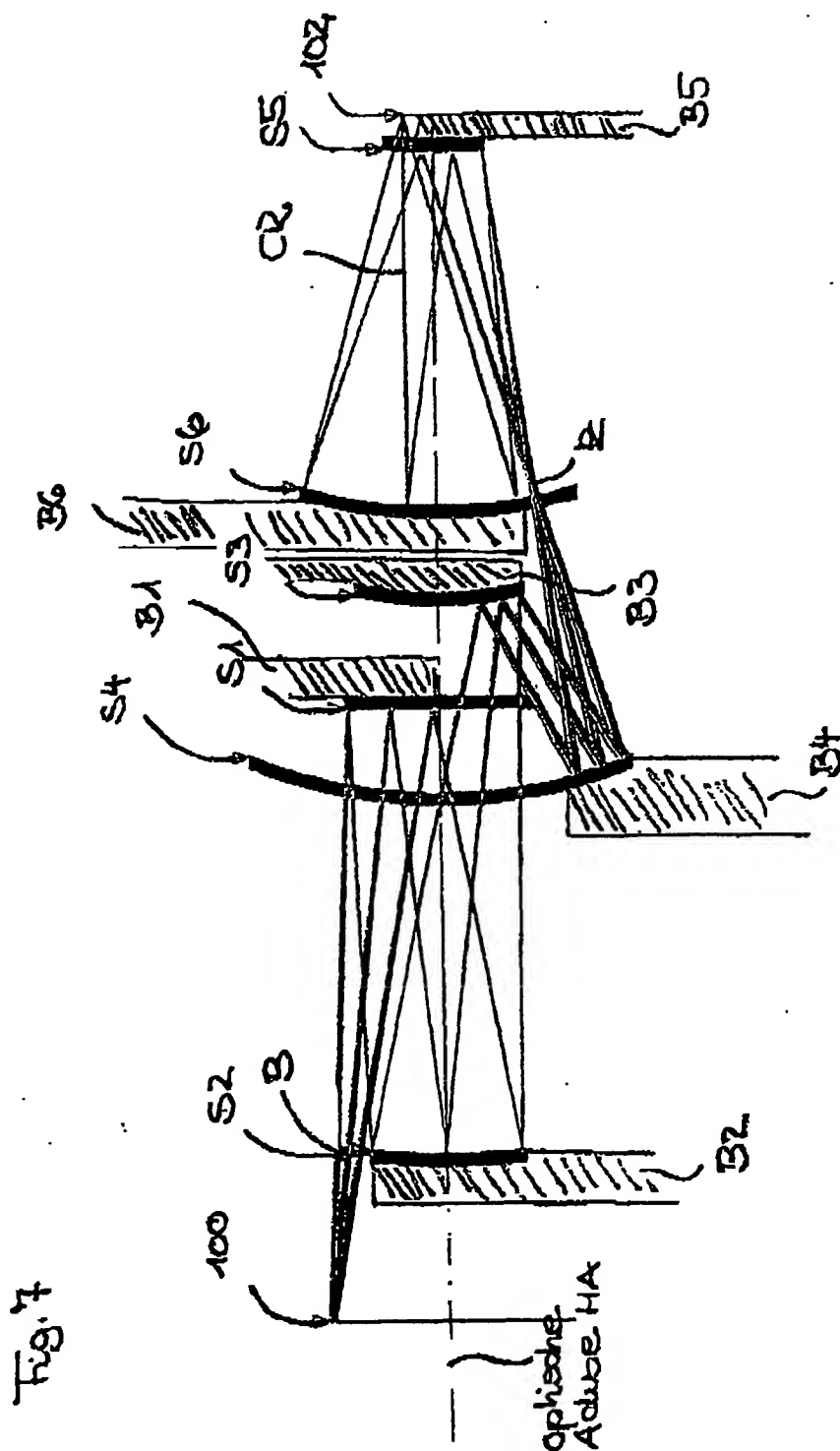
S6

N6

Fig. 6f

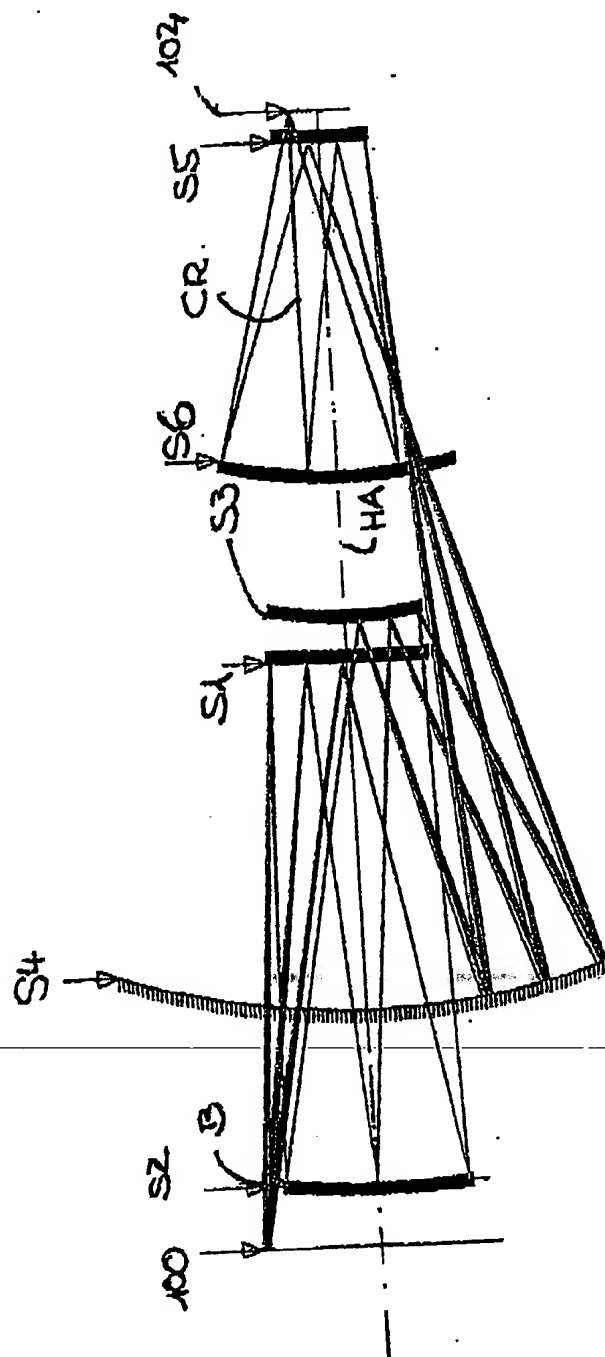
270.054 mm





208.33 NM

1208



208.33 MM

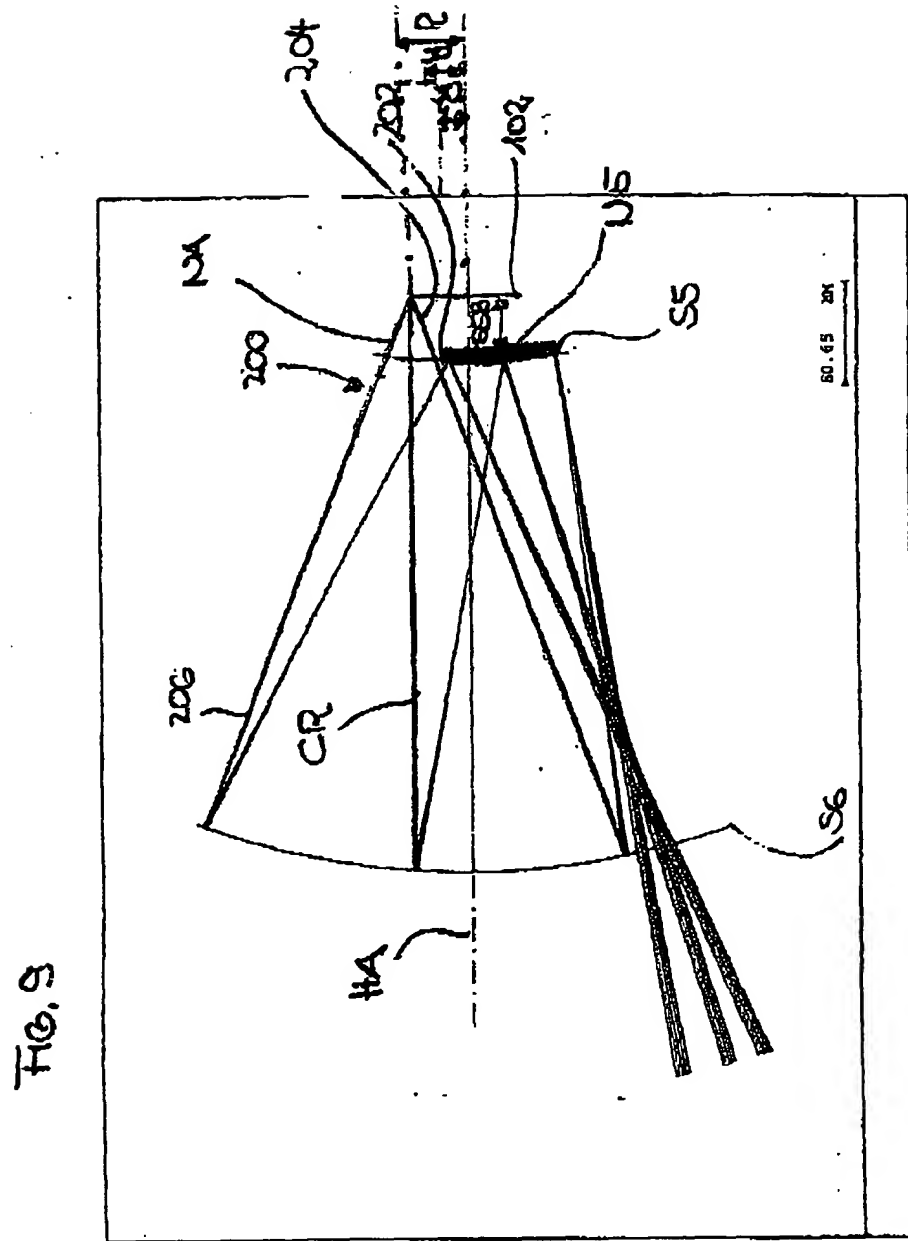


Fig. 10

